

〔国際会議〕

申 請 者	産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 研究センター長 奥村 元	2035003
研究集会名	シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 2013 The International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM 2013)	
開催期間	2013年9月29日～10月4日	
開催場所	シーガイア・コンベンションセンター サミットホール（宮崎県宮崎市）	
申請者の役割	組織委員長	

概 要：

省電力高効率，超小型高耐熱等，従来の半導体を超える特長を有する，次世代パワーデバイス用半導体である，シリコンカーバイド（SiC）は，長年の研究開発の結果，実用デバイスが生産販売されるに至り，幅広い産業分野での応用に急速な関心が集まっています。こうした背景を踏まえ，1987年を嚆矢に，15回目を迎える本国際会議は，SiC関連の最重要会議と位置付けられており，材料作製・評価からデバイスまでの広範な基礎研究分野のみならず，産業応用における課題解決，将来展望にも焦点をあてて，最新の研究開発成果を世界各国から持ち寄り，議論することを目的としています。

会議は，平成25年9月29日から10月4日まで宮崎市のフェニックス・シーガイア・リゾート シーガイア・コンベンションセンターにおいて開催されました。参加者数は795名（参加登録者659名，企業展示出展者136名）に達し，前回2007年の我が国での開催より180名増加しました。参加登録者の43%（283名）が海外からの参加で，欧州127名，米国63名，アジア・オセアニア93名と，真に国際的雰囲気での会議となりました。会議では，2つの基調講演セッション，24の口頭発表セッション，4つのポスター発表セッションにおいて，結晶成長，材料評価，表面・界面，素子プロセス，素子特性，回路・応用等，幅広い議題がとりあげられ，基礎物理から素子応用に至る幅広い分野で，最新の研究開発成果に関する議論がなされました。加えて，企業技術紹介セッションでは，国内外48社からの発表があり，材料メーカ，装置メーカ，分析業者等の61社の展示ブースが会議中併設されるなど，着実に実用化に向けた進展を実感できるものとなりました。